

## aos万代公司AOZ8S401US405

产品名称	aos万代公司AOZ8S401US405
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

## 产品详情

栅极从0v充电到对应电流米勒平台时总充入电荷（实际电流不同，这个平台高度不同，电流越大，平台越高，这个值越大）。这个阶段是给充电也相当于，输入电容。整个米勒平台的总充电电荷（在这称为米勒电荷）。这个过程给这个电容随着电压不同迅速变化充电。在开关过冲中，AOS主要发热区间是粗红色标注的阶段。从 $V_{gs}$ 开始超过阈值电压，到米勒平台结束是主要发热区间。其中米勒平台结束后AOS MOS基本完全打开这时损耗是基本导通损耗MOS内阻越低损耗越低。阈值电压前，AOS MOS没有打开，几乎没损耗只有漏电流引起的一点损耗。其中又以红色拐弯地方损耗最大，充电将近结束，快到米勒平台和刚进入米勒平台这个过程发热功率最大更粗线表示。所以一定充电电流下，红色标注区间总电荷小的管子会很快度过，这样发热区间时间就短，总发热量就低。不过不同厂家标的内阻是有不同测试条件的。测试条件不同，内阻测量值会不一样。同一管子，温度越高内阻越大（这是硅半导体材料在AOS MOS制造工艺的特性，改变不了，能稍改善）。所以大电流测试内阻会增大（大电流下结温会显著升高），小电流或脉冲电流测试，内阻降低因为结温没有大幅升高，没热积累。